

日本物理学会2019年秋季大会プログラム

9/10-13@岐阜大学

No	発表日	講演No	発表時間	会場	セクション	講演タイトル	講演者	区分
1	9/10	10aB14-11	12:00-12:15	B14	領域8	小角中性子散乱から見たカイラル磁性体MnGeのスピンヘッジホッグ格子の変形過程	○金澤直也A, Jonathan WhiteB, Henrik RonnowC, 塚崎敦D, 市川昌和A, 川崎雅司A, E, 十倉好紀A, E (東大工A, PSIB, EPFLC, 東北大金研D, 理研CEMSE)	Oral
2	9/11	11aD15-3	09:30-09:45	D15	領域4	NbSe <sub>2</sub> 超薄膜におけるPauli極限-軌道極限のクロスオーバー	○松岡秀樹A, 中野匡規A, B, 山本慧C, 家田淳一C, 岩佐義宏A, B (東大院工A, 理研CEMSB, 東大物性研C, 東北大金研D)	
3		11aB12-4	09:45-10:00	B12	領域8	Sr <sub>2</sub> RuO <sub>4</sub> 薄膜を用いた弱結合ジョセフソン接合の特性評価	○打田正輝A, B, 桜庭一啓A, 川村稔C, 井出元晴A, 高橋圭B, C, 十倉好紀A, C, 川崎雅司A, C (東大工A, JSTさきがけB, 理研CEMSC)	
4		11pD10-4	14:30-14:45	D10	領域3	MnGe薄膜におけるスピнкаイラリティに由来するスキュー散乱と巨大異常ホール効果	○藤代有絵子, 金澤直也, 栗原綾佑A, 塚崎敦B, 市川昌和, 川崎雅司C, 徳永将史A, 十倉好紀C (東大工, 東大物性研A, 東北大金研B, 理研CEMSC)	
5		11pD16-5	15:15-15:30	D16	領域4	トポロジカル絶縁体表面における半整数量子ホール伝導度の検出	○茂木将孝A, 岡村嘉大A, 川村稔B, 吉見龍太郎B, 安田憲司A, 森本高裕A, 塚崎敦C, 高橋圭B, 高橋陽太郎A, B, 永長直人A, B, 川崎雅司A, B, 十倉好紀A, B (東大工A, 理研CEMSB, 東北大金研C)	
6		11pD16-8	16:00-16:15			磁気近接相互作用による量子異常ホール効果の観測	○吉見龍太郎, 渡邊竜太A, 川村稔, 茂木将孝A, 塚崎敦B, 干秀珍, 中島清美, 高橋圭, 川崎雅司A, 十倉好紀A (理研CEMS, 東大工A, 東北大金研B)	
7		11pK36-10	16:00-16:15	K36	領域5	テラヘルツ放射分光による励起子シフト電流の観測	○五月女真人A, 中村優男A, B, 森本高裕C, 川崎雅司A, C, 十倉好紀A, C, 小川直毅A, B (理研CEMSA, JSTさきがけB, 東大院工C)	
8		9/12	12pK36-7	15:30-15:45			MnGe薄膜におけるテラヘルツ異常ホール効果の膜厚依存性	
9	12pK36-11		16:30-16:45	磁性トポロジカル絶縁体薄膜における量子異常ホール状態の赤外磁気光学分光			○加藤喜大A, 岡村嘉大A, 茂木将孝A, 吉見龍太郎B, 塚崎敦C, 高橋圭B, 川崎雅司A, B, 十倉好紀A, B, 高橋陽太郎A, B (東大工A, 理研CEMSB, 東北大金研C)	
10	9/13	13aB17-4	15:30-15:45	B17	領域8	電荷-軌道秩序を示すマンガン酸化物における急冷効果	○松浦慧介, 大池広志A, V. Kocsis, 佐藤拓朗, 富岡康秀B, 金子良夫, 中村優男, 田口康二郎, 川崎雅司A, 十倉好紀A, 賀川史敬A (理研CEMS, 東大工A, 産総研B)	

2019年秋季第80回応用物理学会プログラム

9/18-21@北海道大学

No	発表日	講演No	発表時間	会場	セクション	講演タイトル	講演者	区分
1	9/18	18p-E311-8	15:00-15:15	E311	6.3酸化物エレクトロニクス	エピタキシャル酸化物界面におけるスピン流の検出	○(M2)寺林 真輝1、関 真一郎2,3、高木 里奈2,3、中村 優男2、川崎 雅司2,3、石橋 幸治2、齋藤 智彦1、松野 丈夫2,4,5 (1.東理大理、2.理研CEMS、3.東大工、4.阪大理、5.JSTさきがけ)	Oral
2	9/20	20a-E201-2	09:15-09:30	E201	17.3層状物質	二次元超伝導体NbSe <sub>2</sub> におけるパウリ極限の角度依存性	○(DC)松岡 秀樹1、中野 匡規1,2、小濱 芳允1,3、王 越1、柏原 悠太1、吉田 訓1、松井 一樹3、下起 敬史3、大内 拓4、石坂 香子1,2、野島 勉4、川崎 雅司1,2、岩佐 義宏1,2 (1.東大院工、2.理研CEMS、3.東大物性研、4.東北大金研)	
3	9/21	20p-C309-9	17:00-17:30	C309	シンポジウム (technical) 強誘電体材料の将来デバイスへの応用	強誘電半導体における低散逸で高速応答のシフト電流光電変換	○中村 優男1,2 (1.理研CEMS、2.JSTさきがけ)	
4		21a-C309-12	12:00-12:15		6.1 強誘電体薄膜	光電流作用スペクトルで見たシフト電流の欠陥耐性	○(M2)畑田 大輝1、中村 優男2,3、金子 良夫2、五月女 真人2、小川 直毅2,3、十倉 好紀1,2、川崎 雅司1,2 (1.東大院工、2.理研CEMS、3.JST さきがけ)	
5		21a-C309-13	12:15-12:30		6.1 強誘電体薄膜	分子線エピタキシー法による強誘電体SbSI薄膜の作製	○稲垣 宗太郎1、中村 優男2,3、畑田 大輝1、西野 隆太郎1、賀川 史敬1,2、十倉 好紀1,2、川崎 雅司1,2 (1.東大院工、2.理研CEMS、3.JSTさきがけ)	